
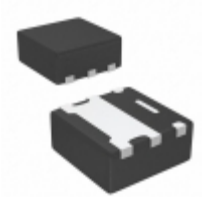







	<h2>SIB900EDK-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIB900EDK-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIB900EDK-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 12000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIB900EDK-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12000 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	225 mOhm @ 1.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.7nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Original-Reel®








SIB900EDK-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIB900EDK-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIB900EDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIB900EDK-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIB488DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB912DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6</p>	 <p>SIB911DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p>SIB488DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 9A SC75-6</p>
 <p>SIB800EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1.5A SC75-6</p>	 <p>SIB911DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p>SIB900EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6</p>	 <p>SIB911DK-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>

heiße Teile

Mehr

 08053C333MAT2A	 0805ZC182JAT2A	 3T011527-29	 ABA3115R	 AD7908BRUZ
 ADP197ACBZ-01-R7	 APA100-101M	 AQY216EHA	 BA3472F-BZE2	 BP-4815S6
 BTB04-400A	 C0402C0G1C160G	 C3225C0G2A153J125AA	 DS1013S-30	 HC-PGC240V15PP5
 HRC0203BTRF-E	 LMC6024IMX/NOPB	 LMK325BJ107MM-T	 LTC2856IMS8-1#TRPBF	 M68717-21
 MAX5068AUT-T	 MC-22004BF1-DB1-B10	 MCZ33904B3EK	 MI-AIM-I1-S	 NJU7036SE3-TE2
 PD200S16 PD230S16	 PS2865-1N-F4	 REG103GA-5	 SD85R14P	 SDT05S/F
 SIB414DK-T1-GE3	 SIB414DK-T1-GE3	 SIB422EDK-T1-GE3	 SIB422EDK-T1-GE3	 SIB437EDKT-T1-GE3
 SIB437EDKT-T1-GE3	 SIB900EDK-T1-GE3	 SIB911DK-T1-GE3	 SIB911DK-T1-GE3	 SIBA 10.NH000
 SK45GAR063	 SKD110/12/	 SMDB05C-LF-T7	 SMP1307-027	 TDA9896HN/V1
 TIP2955G	 TMPC0603H-R82MG-D	 TPA102DGNR	 V375A12M600BL3	 V375B15C300BN

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited